12000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.6 dB (típico) / 0.7 dB (máximo); Nível de limitação: 16.5 dBm (típico) / 17.5 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 43 dBm (máximo) (τ = 1 ms; D = 20%). Dimensões do die: 1.4 × 0.8 × 0.1 mm.

Características RF · TA = +25 °C

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Frequência de operação	-	12000	-	18000	12000–18000	MHz
Perda de inserção	-	-	0.6	0.7	-	dB
VSWR de entrada	-	-	1.4	-	-	-
VSWR de saída	-	-	1.4	-	-	-
Nível de limitação	-	-	16.5	17.5	-	dBm
Potência máxima de entrada pulsada	-	-	-	43	τ = 1 ms; D = 20%	dBm

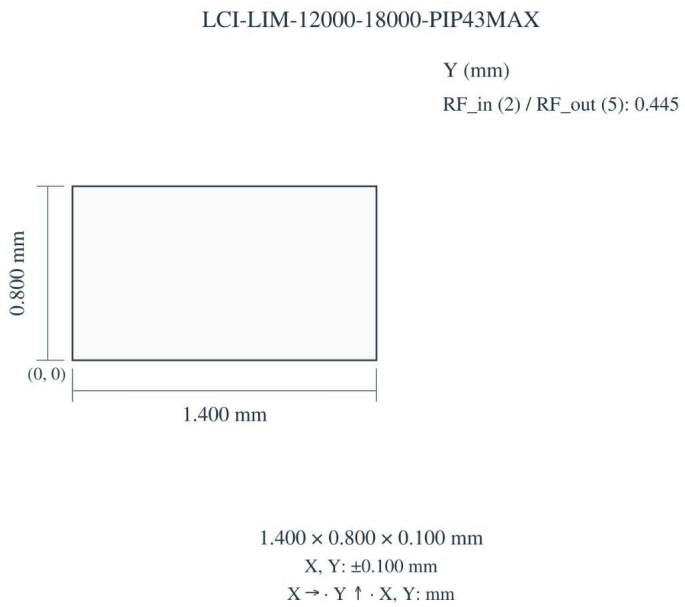
Condições ambientais

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Temperatura de armazenamento	-	-65	-	150	°C
Temperatura de operação	-	-55	-	125	°C

Dimensões do die

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do die	1.4 × 0.8 × 0.1	mm

Desenho dimensional mecânico



Todas as dimensões estão em mm [in].

Atribuição dos pads de ligação

Terminais	Símbolo	Função	Observações
2	RFin	Entrada RF	50 Ω
5	RFout	Saída RF	50 Ω
1, 3, 4, 6	GND	Pad de terra para teste com ponta de prova	-

Registro da publicação atual · 1.4 · 2026-10-27. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.3.

Integração do die e sequência de polarização

A entrada e a saída possuem capacitores de bloqueio DC integrados.

Escopo da referência mecânica

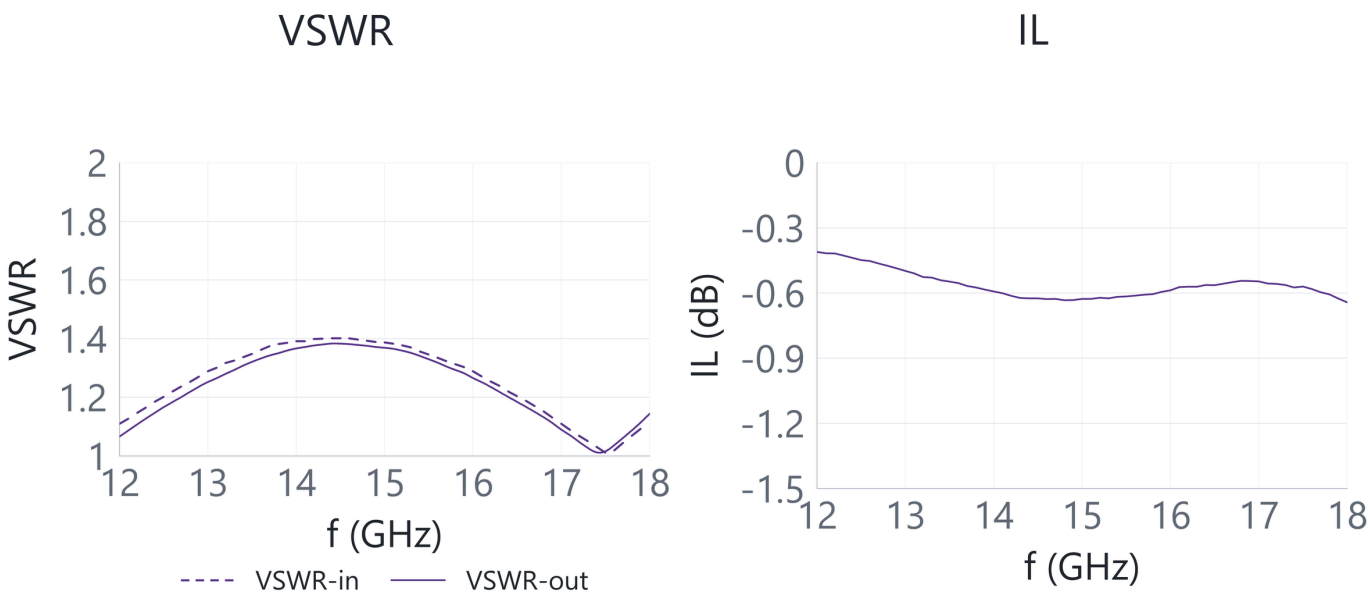
Referência dimensional em mm baseada na documentação de origem. Informações parciais; não constitui um desenho completo de fabricação ou de ligação por fios.

Curvas de desempenho

Gráficos da ficha técnica original. Considere as condições de operação indicadas em cada figura.

Casamento de entrada e saída; Perda de inserção.

Anotação da página original: TA=+25°C. Gráfico redesenhado a partir da figura original; as leituras são aproximadas.



Fonte

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.